PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-039713

(43)Date of publication of application: 13.02.2001

(51)Int.CI.

CO1G 9/02

C03B 8/02

(21)Application number: 11-210145

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

26.07.1999

(72)Inventor: KOBAYASHI KENJI

KANO KOJI

(54) PRODUCTION OF ZINC OXIDE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce high purity zinc oxide by preparing a zinc carbonate precipitate by dissolving high purity zinc in an acid soln. and adding sodium carbonate, or the like, and dehydrating, drying and burning the precipitate.

SOLUTION: The high purity zinc low in transition metal impurities such as Fe, Ni and Cu and having $\geq 99.999\%$ purity is used as a starting material, and the high purity zinc is dissolved in an acid soln. such as hydrochloric acid, nitric acid and sulfuric acid, and high purity acid having $\geq 99.99\%$ purity is used. Then, the high purity sodium carbonate or sodium bicarbonate having $\geq 99.99\%$ purity is added to the zinc soln. after being dissolved to precipitate the zinc carbonate precipitate. The high purity zinc oxide very low in transition metal impurities is obtained by washing the precipitate by adding ultrapure water to the precipitate and agitating the mixture, then dehydrating the precipitate by suction filtration or centrifugal separation, drying it by vacuum drying or in an oxygen atmosphere and burning the dried product in an electric furnace at $\geq 300^{\circ}$ C, preferably at $400-600^{\circ}$ C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.10.2001

[Date of sending the examiner's decision of

01.03.2005

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号 特開 2001 — 39713

(P2001-39713A) (43)公開日 平成13年2月13日(2001.2.13)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

C01G 9/02 C03B 8/0₺

C01G 9/02

B 4G014

CO3B 8/02

A 4G047

(21)出願番号

特願平11-210145

(22)出願日

平成11年7月26日(1999.7.26)

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全6頁)

(72)発明者 小林 健二

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 鹿野 弘二

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

(74)代理人 100082717

弁理士 雨宮 正季

Fターム(参考) 4G014 AH02

4G047 AA02 AB02 AB04 AC03 AD03

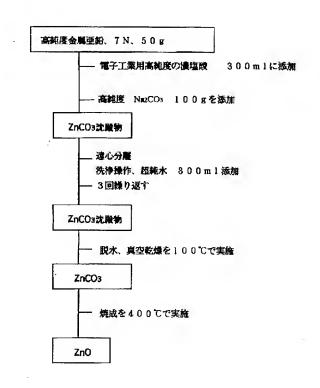
(54) 【発明の名称】酸化亜鉛の製造方法

(57) 【要約】

【課題】高純度の酸化亜鉛を簡便に製造する方法を提供 する。

【解決手段】 高純度亜鉛を出発物質として使用し、前記高純度亜鉛を酸溶液中で溶解し、溶解後の亜鉛溶液に炭酸ナトリウムあるいは炭酸水素ナトリウムを加え、炭酸亜鉛の沈殿物を作製し、該沈殿物を脱水・乾燥し、焼成する。

【効果】従来の亜鉛酸あるいは亜鉛塩の水溶液に二酸化炭素を飽和した炭酸水素ナトリウム溶液で得る方法に比べ、極めて簡便に無水の酸化亜鉛を作製することができ、遷移金属を極低濃度にした高純度の酸化亜鉛を製造することができる。さらに、酸化亜鉛をテルライトガラスファイバを用いた光増幅器の出発物質として用いることにより、増幅度の高い光ファイバアンプを製造できる利点がある。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高純度亜鉛を出発物質として使用し、前 記高純度亜鉛を酸溶液中で溶解し、溶解後の亜鉛溶液に 炭酸ナトリウムあるいは炭酸水素ナトリウムを加え、炭 酸亜鉛の沈殿物を作製し、該沈殿物を脱水・乾燥し、焼 成することを特徴とする酸化亜鉛の製造方法。

1

【請求項2】 高純度亜鉛が純度99.999%以上の 高純度金属であり、炭酸ナトリウムあるいは炭酸水素ナ トリウムも純度が99.99%以上の高純度の試薬であ り、酸についても純度が99.99%以上の高純度の試 10 薬であることを特徴とする請求項1記載の酸化亜鉛の製 造方法。

【請求項3】 前記焼成温度は300℃以上であること を特徴とする請求項1又は2記載の酸化亜鉛の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高純度の酸化亜鉛 の製造方法、更に詳細には光増幅器用高純度酸化物原料 の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】酸化亜鉛(ZnO)は、光増幅媒体と、 これを用いた光増幅器およびレーザ装置のもとになる二 酸化テルルを主成分とするテルライトガラスまたはテル ライトガラスファイバの構成原料の一つである。

【0003】従来の酸化亜鉛の製造方法については、亜 鉛酸の水溶液に二酸化炭素を飽和した炭酸水素ナトリウ ム溶液の作用で得る方法、具体的には、亜鉛塩の硫酸亜 鉛の水溶液に炭酸水素カリウム溶液を加えて炭酸亜鉛を 作製後、高温で焼成し製造する。

【0004】すなわち、さらに具体的には、従来法で は、硫酸亜鉛のような亜鉛塩の水溶液、亜鉛酸の水溶液 を出発物質とし、該水溶液に炭酸ナトリウム、あるい は、炭酸水素ナトリウムの溶液を加え、各々、塩基性の 炭酸亜鉛、中性の炭酸亜鉛を作製後、高温で焼成し、酸 化亜鉛を得るものである。

【0005】従来の酸化亜鉛の製造方法については、出 発物質として亜鉛塩あるいは亜鉛酸の水溶液を使用して いる。亜鉛塩あるいは亜鉛酸の水溶液は、高純度の亜鉛 ても高純度のものが得られていない点が欠点である。さ らに、従来法においては、使用した硫酸亜鉛の硫酸の痕 跡が製造した酸化亜鉛中に不純物として残り、これを除 くために、800℃以上で加熱し、硫酸の痕跡を除いた 酸化亜鉛としなければならない煩雑さがある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、出発 物質にFe,Cu,Niなどの遷移金属の不純物を除去 した高純度の金属亜鉛を使用することにより、亜鉛塩あ

る純度の低い酸化亜鉛の製造の欠点を解決した高純度の 酸化亜鉛を製造する方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明による酸化亜鉛の製造方法は、高純度亜鉛を 出発物質として使用し、前記高純度亜鉛を酸溶液中で溶 解し、溶解後の亜鉛溶液に炭酸ナトリウムあるいは炭酸 水素ナトリウムを加え、炭酸亜鉛の沈殿物を作製し、該 沈殿物を脱水・乾燥し、焼成することを特徴とする。

【0008】すなわち、いかなる形状の高純度金属亜鉛 についても高純度金属亜鉛を塩酸、硝酸、硫酸などの酸 溶液内で溶解させた後、溶解後の水溶液に炭酸ナトリウ ムあるいは炭酸水素ナトリウムを添加し、炭酸亜鉛の沈 殿物を作製し、該沈殿物を脱水・乾燥し、炭酸亜鉛と し、これをさらに300℃以上で焼成し、高純度の酸化 亜鉛とすることを特徴とする。

【0009】本発明は、従来技術の亜鉛酸あるいは亜鉛 塩の水溶液に炭酸ナトリウムもしくは炭酸水素ナトリウ ム溶液を加え、塩基性あるいは中性の炭酸亜鉛から酸化 20 亜鉛を製造する方法などの問題点を解決するために、F e, Ni, Cuなどの遷移金属不純物の少ない純度が9 9.99%以上の高純度の金属亜鉛について、粉末状 に限らず、ショット状、インゴット状のあらゆる形状の 金属亜鉛を出発物質に使用し、遷移金属不純物の少ない 酸化亜鉛、特に、高純度の酸化亜鉛を製造するものであ る。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体的に説明す る。本発明において出発物質として使用する金属亜鉛の 30 内、用途上、高純度の亜鉛が有用である。高純度の程度 は、99.999%以上、すなわち、5N以上が好まし い。また、金属亜鉛の形状には制限されるものではな い。すなわち、粉末状、インゴット状、ショット状のど の形状でも良い。

【0011】本発明において、上述のような高純度亜鉛 を酸によって溶解する。酸による溶解は特殊な条件を必 要とせず、該金属亜鉛を塩酸、硝酸、硫酸などの酸溶液 中に溶解できる条件であればよい。また、該金属亜鉛を 溶解した溶液の加熱溶解については、特殊な条件を必要 水溶液を使用していないので、製造した酸化亜鉛につい 40 としない。前記酸としては前述のように塩酸、硝酸、硫 酸などを使用することができ、その純度は、高純度酸化 亜鉛を製造するためには99.99%以上が好ましい。 【0012】次に、この亜鉛溶液に炭酸ナトリウムある いは炭酸水素ナトリウムを添加して炭酸亜鉛を沈殿さ せ、洗浄、乾燥する。このような炭酸ナトリウムあるい は炭酸水素ナトリウムも高純度酸化亜鉛を製造するため には、純度が99.99%以上であるのが好ましい。

【0013】炭酸亜鉛の水和物の洗浄操作も超純水を加 え、攪拌しながら洗浄を行えば良く、また、脱水も常用 るいは亜鉛酸などの不純物の多い水溶液を出発物質とす 50 の方法でよく、操作上、吸引ろ過又は遠心分離器が好適

である。最後に、乾燥および焼成についても常用の方法でよく、操作上、真空乾燥又は酸素雰囲気での乾燥および酸素雰囲気における電気炉における焼成が好適である。焼成温度は300℃以上であるのがよい。300℃未満であると、CO₁が充分放散しない恐れがあるからである。基本的に焼成温度の上限は限定されるものではないが、あまり高温であると、エネルギーの損失が多く、効率的ではなくなる。特に好ましくは400~600℃である。

【0014】以上、具体的に説明したように、本発明方 10 O。)である。 法において、特に、高純度の酸化亜鉛を製造する方法の 【0021】 場合には、従来技術の亜鉛塩あるいは亜鉛酸を出発物質 。)のFe, N とし、酸に溶解し、炭酸ナトリウムあるいは炭酸水素ナ i, Cuにつ の分析結果が 酸化亜鉛とする方法とは、高純度金属亜鉛を出発物質と ついてのFe, る高純度の酸に溶解する点、高純度の炭酸ナトリウム 3 桁以上の高 あるいは炭酸水素ナトリウムを添加する点で異なる。 施例における

[0015]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。

[0016]

【実施例1】純度:7N(99.99999%)の高純 度金属亜鉛を出発物質とする高純度酸化亜鉛の製造方法 について、図1に示す工程図によって説明する。形状が ショット状の高純度亜鉛50gを秤量し、1000ml のビーカに入れ、電子工業用の高純度の濃塩酸(塩化水 素含有量36%)300mlに溶解する。溶解に要する 時間は30分程度で、溶解後の水溶液は無色であり、無 色の溶液を孔径0.2μのメンブランフィルタを通し、 未溶解の亜鉛がある場合にはメンブランフィルタで未溶 30 きた。 解亜鉛を除去する。該水溶液に、純度が99.99%の 高純度炭酸ナトリウム (Na, CO,) 100gを少量づ つ添加し、ZnCO。沈殿物を得る。該沈殿物は、遠心 分離器で沈殿物と水溶液を分離する。分離後の沈殿物 は、再度、1000mlのピーカに入れ、超純水を80 0ml添加し、洗浄を行う。洗浄操作は、3回繰り返 す。洗浄後のZnC〇。沈殿物は、遠心分離器で分離 し、分離後のZnC〇。沈殿物は、真空乾燥器で100 ℃で24時間乾燥し、脱水を行い、高純度の炭酸亜鉛 (ZnCO3) を製造後、清浄な酸素雰囲気の電気炉内 で400℃において焼成し、酸化亜鉛とする。反応式 は、式1、式2、式3の反応で高純度酸化亜鉛が製造で きる。

[0017]

[式1] $Zn+4HC1 \rightarrow ZnC1_4^{2}+2H_2$ [0018]

[式2] $Z n C I_1^2 + N a_2 C O_3 \rightarrow Z n C O_3 + 2$ N a C $I + C I_2$

[0019]

[式3] $ZnCO_3 \rightarrow ZnO+CO_7$

【0020】図2は、真空乾燥後の炭酸亜鉛のTG(熱重量分析)-DTA(示差熱分析)曲線である。なお、図2において、横軸は温度(\mathbb{C})、左縦軸はTGにおける重量減少率(%)、右縦軸はDTAにおける熱容量(μV)を意味する。図2から、 $150\mathbb{C} \sim 300\mathbb{C}$ 付近に炭酸亜鉛から二酸化炭素が放出され、酸化亜鉛(ZnO)となる吸熱ピークが観察された。すなわち、X線回折(XRD)及び熱分析(TG-DTA)での解析結果より、作製した物質は、無水の炭酸亜鉛(ZnCO、)である

【0021】また、作製した無水の炭酸亜鉛(ZnCO」)のFe, Ni, Cuの放射化分析を行い、Fe, Ni, Cuについて各元素とも不純物濃度は1ppb以下の分析結果が得られ、従来、製造されていた酸化亜鉛についてのFe, Ni, Cuの不純物濃度の定量値よりも3桁以上の高純度の無水の酸化亜鉛が作製できた。本実施例における高純度の無水の酸化亜鉛の収率は90%である。

【0022】本実施例で作製した酸化亜鉛(ZnO)を 20 副成分とし、これに、主成分の二酸化テルル(TeO_2)と他の副成分の Na_1O と Bi_2O_3 を添加したテルライトガラスファイバ(コアガラス組成: $TeO_2-ZnO-Na_2O$)のシングルモードファイバを作製したところ、波長が 1.3μ において損失値10dB/kmのファイバが作製できた。これは、従来品のテルライトガラスファイバが、市販のZnO原料を使用したために 1.3μ における損失値が100dB/kmと高い値を示したのに対し、大幅な損失値の低減が達成で

[0023]

【実施例2】純度:6N(99.9999%)の高純度 金属亜鉛を出発物質とする高純度酸化亜鉛の製造方法に ついて、図3に示す工程図によって説明する。形状がイ ンゴット状の高純度金属亜鉛25gを秤量し、1000 mlのビーカに入れ、電子工業用の高純度の濃硝酸(6 1%、比重=1. 42g/cm³) 300mlに超純水 200mlを加えた希硝酸に溶解する。溶解に要する時 間は、約1時間である。溶解後の水溶液は無色であり、 40 無色の溶液を孔径 0.2 μのメンブランフィルタを通 し、未溶解の金属亜鉛があった場合にはメンプランフィ ルタで除去する。溶解後の該水溶液に、純度が99.9 9%の高純度炭酸ナトリウム (Na, CO,) 100gを 少量づつ添加し、ZnC〇。沈殿物を得る。該沈殿物 は、遠心分離器で沈殿物と水溶液を分離する。分離後の 沈殿物は、再度、1000mlのビーカに入れ、超純水 を800m1添加し、洗浄を行う。洗浄操作は、3回繰 り返す。洗浄後のZnC○₃沈殿物は、遠心分離器で分 離し、分離後のZnC〇。沈殿物は、真空乾燥器で17 50 0℃において24時間乾燥し、脱水を行い、高純度の炭

酸亜鉛(ZnC〇。)を製造後、清浄な酸素雰囲気の電 気炉内で600℃で焼成し、酸化亜鉛とする。

【0024】反応式は、式4、式5に従い、炭酸亜鉛が 製造できる。さらに、炭酸亜鉛を600℃で焼成すると 式6に従い、酸化亜鉛が作製できる。TG-DTA分析 によるDTA曲線においても図2に示したDTA曲線と 同一のものが得られ、X線回折(XRD)及び熱分析 (TG-DTA) での解析結果より、作製した物質は、 酸化亜鉛である。また、作製した酸化亜鉛のFe, N i, Cuの放射化分析を行い、Fe, Ni, Cuについ 10 て不純物濃度1 p p b の分析結果が得られ、従来、行わ れていた酸化亜鉛についてのFe, Ni, Cu不純物濃 度の定量値よりも3桁以上の高純度の無水の酸化亜鉛が 95%の収率で作製できた。

[0025]

【式4】 $Zn + 2HNO_3$ → $Zn^{2} + 2NO_3$

 $\texttt{(式5)} \ \mathsf{Zn^{2+}} + \mathsf{Na_2CO_3} + \mathsf{H_2O} \rightarrow \mathsf{ZnCO_3} + \mathsf{H_2O_3} +$ 2NaOH

[0027]

[式6] $ZnCO_3 \rightarrow ZnO+CO_2$

【0028】本実施例で作製したZnOを用い、これに TeО₂ を加えたテルライトガラスファイバ (コアガラ ス組成:TeO2-ZnO-Na2O-Bi2O3、クラッ ドガラス組成:TeO:-ZnO-Na:O) において、 1. 3 μ の波長で損失値 1 0 d B / k m のシングルモー ドファイバが作製できた。これは、従来のテルライトフ ァイバ原料がTeO₂に市販のZnOの原料を用いて作 製したシングルモードファイバが、損失値1000dB /kmであるのに対し、大幅な損失値の低減が達成でき 30 のに対して、大幅な損失値の低減ができた。

[0029]

【実施例3】純度:6N(99、9999%)の高純度 の金属亜鉛を出発物質とする高純度酸化亜鉛の製造方法 について、図4に示す工程図によって説明する。形状が チャンク状の高純度金属亜鉛50gを秤量し、1000 m l のビーカに入れ、電子工業用の高純度の濃硫酸 (9 6%) 300mlに超純水200mlを加えた希硫酸水 溶液で溶解する。溶解と同時に白色の硫酸亜鉛の沈殿物 を得る。硫酸亜鉛の沈殿物をホットプレート上で加熱 し、溶解する。溶解後の亜鉛水溶液は無色であり、溶解 後の該水溶液に、純度が99. 99%の高純度炭酸ナト リウム (Na₂CO₂) **100gを300mlの超純水**に 溶解した水溶液を少量づつ添加し、ZnCO。沈殿物を 得る。該沈殿物は、遠心分離器で沈殿物と水溶液を分離 する。分離後の沈殿物は、再度、1000mlのピーカ に入れ、超純水を800m1添加し、洗浄を行う。洗浄 操作は、3回繰り返す。洗浄後のZnCO,沈殿物は、 速心分離器で分離し、分離後のZnCO。沈殿物は、真 空乾燥器で130℃で24時間乾燥し、脱水を行い、高 50

純度の炭酸亜鉛 (ZnCO₃) を製造後、清浄な酸素雰 囲気の電気炉内で600℃で焼成し、酸化亜鉛とする。 【0030】反応式は、式7、式8、式9、式10に従 い、酸化亜鉛が製造できる。

[0031]

【式7】 $Zn+H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4\downarrow +H_2$

[0032]

【式8】 ZnSO, → Zn²++SO,²-

[0033]

[式9] $Zn^{2+}+CO_3^{2-} \rightarrow ZnCO_3$

[0034]

[式10] ZnCO₃ \rightarrow ZnO+CO₂

【0035】TG-DTA分析は、図2に示した曲線と 同一のものが得られる。すなわち、X線回折(XRD) 及び熱分析(TG-DTA)での解析結果より、作製し た物質は、無水の酸化亜鉛である。また、作製した無水 の酸化亜鉛のFe, Ni, Cuの放射化分析を行い、F e, Ni, Cuについて不純物濃度が1ppbの分析結 果が得られ、従来、行われていた酸化亜鉛についてのF 20 e, Ni, Cu不純物濃度の定量値よりも3桁ほど高純 度の無水の酸化亜鉛が95%の収率で作製できた。

【0036】本実施例で作製した2n0に主組成として Te〇₂を添加したテルライトガラスファイバ(コアガ ラス組成:TeO2-ZnO-Na2O-Bi2O3、クラ ッドガラス組成:TeO₂-ZnO-Na₂O)でシング ルモードファイバを作製したところ、波長1. 3μの損 失値10dB/kmが得られ、従来のテルライトガラス 原料が市販ΖηΟの原料を用いたために、1. 3μにお いて、1000dB/kmの損失値しか得られなかった

[0037]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の製造方法 によれば、高純度の金属亜鉛を出発物質とし、高純度の 酸に溶解後、炭酸ナトリウムあるいは炭酸水素ナトリウ ムを加え、炭酸亜鉛の沈殿物を作製後、脱水・乾燥後、 焼成すれば、無水の高純度の酸化亜鉛が作製できる。特 に、従来の亜鉛酸あるいは亜鉛塩の水溶液に二酸化炭素 を飽和した炭酸水素ナトリウム溶液または炭酸ナトリウ ム溶液の作用で得る方法に比べ、極めて簡便に無水の酸 40 化亜鉛を作製するものであるから、遷移金属を極低濃度 にした高純度の酸化亜鉛を製造することができるもので ある。さらに、酸化亜鉛をテルライトガラスファイバを 用いた光増幅器の出発物質として用いることにより、増 幅度の高い光ファイバアンプを製造できる利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1における高純度の酸化亜鉛の 製造方法を示す工程図。

【図2】本発明の実施例1により作製した炭酸亜鉛のT G-DTA曲線を示す図。

【図3】本発明の実施例2における高純度の酸化亜鉛の

8 製造方法を示す工程図。

製造方法を示す工程図。

【図4】本発明の実施例3における高純度の酸化亜鉛の

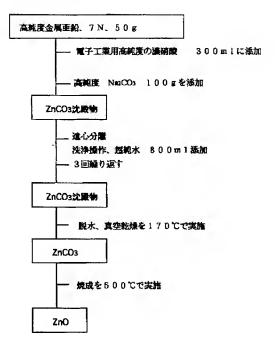
【図1】

高純度金属亜鉛、7 N、5 0 g
- 電子工業用高純度の機塩酸 300 m 1 に添加
- 高純度 NmCO3 100 g を添加
- 遠心分離
- 流浄操作、短純水 800 m 1 添加
- 3回繰り返す
- 脱水、真空乾燥を100 Cで実施
- ZnCO3 に

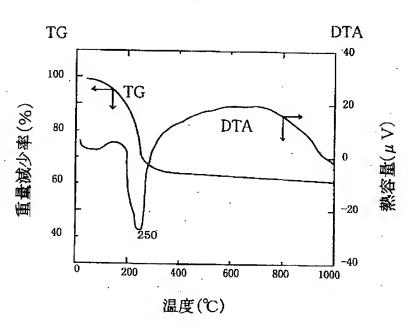
焼成を400℃で実施

ZnO

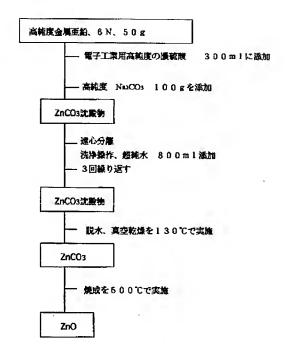
[図3]



[図2]



【図4】



,